

2012年4月10日

セミパワーMOSFET8 製品の仕様

タイプ	製品名	ドレイン・ソース間電圧 【VDSS】(V)	ゲート・ソース間電圧 【VGSS】(V)	ドレイン電流 【ID】(A)	オン抵抗【RDS(on)】(mΩ)							
					VGSS=10V		VGSS=4.5V		VGSS=2.5V		VGSS=1.8V	
					typ	max	typ	max	typ	max	typ	max
Pch-Single	μ PA2630	-12	±8	-7.0	-	-	22	27	26	35	35	56
	μ PA2631	-20	±8	-6.0	-	-	27	34	32	43	41	65
Pch-Dual	μ PA2672	-12	±10	-4.0	-	-	54	67	68	92	112	179
	μ PA2670	-20	±10	-3.0	-	-	64	79	78	105	125	199
Nch-Single	μ PA2600	20	±12	-7.0	-	-	9.3	11.6	12	16	-	-
	μ PA2601	30	±20	-7.0	10.5	13.2	13.6	18	-	-	-	-
Nch-Dual	μ PA2660	20	±12	4.0	-	-	33	42	43	62	-	-
Nch-Pch	μ PA2690	20	±12	4.0	-	-	33	42	43	62	-	-
		-20	±10	-3.0	-	-	64	79	78	105	125	199

以上